

# 化合物電子デバイス・プロセス技術の進展 ～GaAsの繁栄から学ぶ・温故知新～

Progress of compound semiconductor device technologies:  
what can learn from history of GaAs device development

20年以上の年月をかけてSiC, GaNをはじめとするワイドバンドギャップ材料は電子デバイスの実用化に成功し、研究人口、発表の件数は増加の一途を辿っています。しかし、その一方で、ワイドバンドギャップ材料しか経験がない、もしくは黎明期の苦労を知らない若手研究者も増加しています。本シンポジウムでは化合物半導体材料、デバイスの歴史をふり返り、それらの知見を新材料の開発に役立ててもらおうよう、GaAs、InP等の研究開発の経緯を講演して頂くだけでなく、ワイドバンドギャップ材料側からの見解も盛り込んだセッションを企画しました。

**日時** 2018年3月17日(土) 13:15~16:20

**会場** 早稲田大学 西早稲田キャンパス

講演  
予定者  
一般講演:  
数件募集

敬称略, 五十音順

井田実、白鳥悠太 (NTT)

(InP HBT研究開発の歩み ~四半世紀を振り返る~)

塩島謙次 (福井大)

(GaN材料の結晶評価、電極形成技術のふり返り)

高橋剛、牧山剛三 (富士通)

(高周波アプリケーション向けHEMTの現状と将来)

田中丈士 (サイオクス)

(高周波素子用GaN MOCVDエピの進展)

三島友義 (法政大)

(AlGaAs/InGaAs系 MBEの高純度化から始めた電子デバイス用エピ量産技術)

米澤喜幸 (産総研)

(SiCデバイス開発の現状と今後)

学生さん、若手研究者の皆様もぜひご来場ください!!